# Misure

#### Errori 1

Incertezza Tipica:  $\pm (\% lettura + \% fondo - scala)$ 

Strumento di classe x: lo strumento ha una precisione pari ad x\% del fondo-scala

Strumento di ciasse x. 10 strumento na una properti di ciasse x. 10 str

Errore Relativo:  $y \text{ misura } \rightarrow \epsilon_r = \frac{\delta y}{y} \ (\epsilon_{r,\%} = 100 \cdot \epsilon_r)$ 

Somma/Differenza:  $y = a \pm b \rightarrow \delta y = \delta a + \delta b$  gate

Prodotto/Divisione:  $y = a \cdot b^{\pm 1} \rightarrow \epsilon_y = \epsilon_a + \epsilon_b$ Potenza/Radice:  $y = x^{\pm n} \rightarrow \epsilon_y = n^{\pm 1} \epsilon_x$ 

### 2 Attrezzature

Errore di Lettura (Parallasse): valore di una "tacchetta"

**Prodotto Banda Guadagno:**  $B \cdot t_{salita} = 0.35$  (varia col modello dell'oscilloscopio)

Relazione Salita-Visualizzato:  $t_{s,visualizzato}^2 = t_{s,segnale}^2 + t_{s,circuito}^2 + t_{s,oscilloscopio}^2$ 

Solitamente il  $t_{so}$  è trascurabile.

Valor-Medio:  $v_m = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} v(t)dt$  Valore Efficace:  $v_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} v^2(t)dt}$ 

Duty-Cycle:  $D = \frac{t_{alto}}{T}$  Sensibilità:  $k_v = n \frac{mV}{div}$  Lettura:  $n_{div} = n \ div \rightarrow V_{pp} = k_v \cdot n_{div}$ 

Voltmetro a Doppia Rampa:  $V_x = -\frac{T_2}{T_1}V_{rif}$  Incertezza di Quantizzazione:  $\delta f_q = \frac{1}{T_{mis}}$ 

Frequenzimetro a Misura Diretta:  $f_x = \frac{1}{t_x} = \frac{n}{T_c}$ ,  $T_x = nT_c$ 

Risoluzione:  $\delta f_x = \frac{1}{T_c}$  Risoluzione Relativa:  $\frac{\delta f_x}{f_x} = \frac{1}{n}$  Scelta di  $T_1$ : n(t) ruomore di periodo  $T \to T_1 = T$  (spesso 50 Hz)

Riscaldamento di un Resistore:  $T_{fin} - T_{amb} = R_{termica} \cdot P_{dissipata}$ 

Ponte di Wheatstone: All'equilibrio, la ddp ai due nodi centrali è nulla

**Potenza**  $P = \frac{v_{eff}^2}{R}$ , per segnali sinusoidali  $v_{eff} = \frac{A}{\sqrt{2}}$ 

Costante Strumentale:  $k_s = 1.11$  (semionda doppia) —  $k_s = 2.22$  (semionda singola)

Gli strumenti spesso riportano il valore efficace di un segnale. Questo valore è pari alla costante strumentale moltiplicata per il suo valor medio. Ricordate, nel calcolo del valor medio, che nel caso della semionda semplice la parte negativa del segnale viene azzerata.

Condensatore in ingresso: Rimuove la componente continua, cioè il segnale viene scalato in basso per un valore pari al suo valor medio

# Elettronica

## Segnali 1

Signal-to-Noise Ratio:  $SNR = \frac{P_{segnale}}{P_{rumore}} = \frac{v^2}{n^2}$ 

**SNR** in dB:  $SNR_{dB} = 10log_{10}(SNR) = 20log_{10}(\frac{v}{r})$ 

Errore di Quantizzazione:  $\epsilon_q = \frac{S}{2^N + 1} = \frac{1}{2}LSB$ , con S dinamica del segnale

### 2 Diodi

**Polarizzazione Diretta:**  $v_D > 0, i_D \to \infty$ , curva verticale per  $v_D > V_\gamma \simeq 0.6 - 0.7~V$ 

**Polarizzazione Inversa:**  $v_D < 0, i_D$  satura a valori piccoli e negativi (pA-fA)

Diodo Reale:  $i_D = I_s(e^{\frac{v_D}{\eta V_T}} - 1)$ 

**Diodo Ideale:**  $i_D > 0 \rightarrow v_D = 0, ON \mid v_D < 0 \rightarrow i_D = 0, OFF$  (nel circuito: generatore)

**Diodo Semi-Ideale:**  $i_D > 0 \rightarrow v_D = \dot{V}_{\gamma}, ON \mid v_D < V_{\gamma} \rightarrow i_D = 0, OFF$  (nel circuito: corto)

Resistenza di un Diodo (Piccolo Segnale):  $g_D = \frac{1}{r_D} = \frac{I_D}{nV_T}$ 

#### 3 **Transistors**

Corrente di Gate:  $i_G = 0$  in condizioni statiche per NMOS e PMOS. (BJT > 0)

**nMOS:**  $v_{GS}$ ,  $v_{DS}$ **pMOS:**  $v_{SG}$ ,  $v_{SD}$ 

"Trucco" Mnemonico: Il Source è sempre dov'è la corrente. Il Gate sempre la sbarra. Il Drain il rimanente. Per capire se usare  $v_{GS}$  o  $v_{SG}$ , bisogna posizionare due tensioni verso l'alto, una tra le due "gambe" del transistor (che sarà  $v_{DS}$  o  $v_{SD}$ ) e una tra Gate e Source (che sarà  $v_{GS}$  o  $v_{SG}$ ), ricordando che  $v_{XY}$  è una tensione con la punta in X e la coda in Y.

Condizioni Saturazione:  $v_{GS/SG} > V_{TH}, v_{DS/SD} > v_{GS/SG} - V_{TH}$ 

Corrente di Drain (xMOS):

 $OFF \to i_D = 0 \mid ON \to i_D = \beta v_{DS} (v_{GS} - V_{TH} - \frac{v_{DS}}{2}) \mid SAT. \to i_D = \frac{\beta}{2} (v_{GS} - V_{TH})^2 (1 + \lambda v_{DS})$ 

Resistenze:  $g_m = \sqrt{2I_D\beta} = \beta(v_{GS} - v_{TH})$   $g_o = \lambda I_D$ 

## Stadi Amplificatori 4

Tensione Ideale:  $R_{in} \to \infty$ ,  $R_{out} \to 0$  Corrente Ideale:  $R_{in} \to 0$ ,  $R_{out} \to \infty$ 

Transconduttanza: cioè  $i_{out} = g_m v_{qs}$ , ideale se  $R_{in} \to \infty$ ,  $R_{out} \to \infty$ 

Transresistenza: cioè  $v_{out} = R_m i_s$ , ideale se  $R_{in} \to 0, R_{out} \to 0$ Efficienza Amplificatore Potenza:  $\eta = \frac{P_{out}}{P_{al} + P_{in}} \simeq \frac{P_{out}}{P_{al}}$ 

Common Source:  $A_v < 0, R_{in} \to \infty R_{out} = \text{finita}$ 

Common Drain:  $A_v < 1$ ,  $R_{in} \to \infty$   $R_{out} \simeq \frac{1}{q_m}$ 

Common Gate:  $A_v \simeq g_m(R||r_o) \ R_{in} \simeq \frac{1}{g_m} \ \tilde{R}_{out} = R||r_o|$ Effetti di Carico: Uno stadio si comporta come un amplificatore con generatore pilotato.

Trovata  $R_{in}$  ed  $R_{out}$ , rappresenta il blocco centrale di un circuito di mezzo tra un generatore in ingresso  $v_{in}$  con resistenza  $R_S$  e un'uscita  $v_{out}$  con resistenza  $R_L$ . Si puo ricavare l'uscita  $v_{out}$  in funzione dell'ingresso  $v_{in}$  (e quindi la funzione di trasferimento  $A_{v,s}$ ) eseguendo semplici partitori

Esempio: se lo stadio è un partitore di tensione, allora  $v_{out} = v_{in} \frac{R_{in}}{R_{in} + R_S} A_v \frac{R_L}{R_L + R_{out}}$ 

## 5 Amplificatori Operazionali

Relazione Fondamentale (ideale):  $v_d = 0 \rightarrow v^+ = v^- \quad i^+ = i^- = 0$ 

Amplificatore di Tensione:  $A_v = 1 + \frac{R_2}{R_1}, R_{in} \to \infty, R_{out} \to 0$ 

Amplificatore di Transconduttanza:  $G_m = \frac{1}{R}$  (quella in retroazione),  $R_{in} \to \infty$ ,  $R_{out} \to \infty$ Amplificatore di Transresistenza:  $R_m = R$  (quella in retroazione),  $R_{in} \to 0$ ,  $R_{out} \to 0$ 

Amplificatore di Corrente:  $A_i = 1 + \frac{R_2}{R_1}, R_{in} \to 0, R_{out} \to \infty$ 

Voltage-Follower:  $v_{out} = v_{in}, R_{in} \to \infty, \vec{R}_{out} \to 0$ 

Invertente:  $A_v = -\frac{R_2}{R_1}, R_{in} = R_1, R_{out} \to 0$ 

Esponenziale: Diodo su  $R_1$  Logaritmico: Diodo su  $R_2$  Integratore: Condensatore su  $R_2$ 

**Derivatore:** Condensatore su  $R_1$  (Per tutti e 4:  $R_{out} = 0$ )

Sommatore Generalizzato:  $v_{out} = \frac{\sum_{i=0}^{M} G_{i^-} + G_f}{\sum_{i=0}^{N} G_{i^+}} \sum_{i=1}^{N} \frac{G_{i^+}}{G_f} v_{i^+} - \sum_{i=1}^{M} \frac{G_{i^-}}{G_f} v_{i^-}$ 

(Non usare questa formula, meglio sovrapposizione e/o Millman

Common-Mode Rejection Ratio (CMRR):  $\left| \frac{A_d}{A_{cm}} \right|$ ,  $v_{cm} = \frac{v^+ + v^-}{2}$ ,  $v_d = v^+ - v^-$ 

# Limiti Amplificatori Operazionali 6

Circuito Eq. in Linearità:  $v_{out} = A_d v_d + A_{cm} v_{cm} + A_{ps} v_{ps}$ Amplificazione Differenziale Finita:  $A_v = \frac{\beta A_d}{1 + \beta A_d} \frac{1}{\beta} \to \frac{1}{\beta} = 1 + \frac{R_2}{R_1} \text{ se } A_d \to \infty$ Banda Amplificazione:  $B = \beta f_T$  Parametro Beta:  $\beta = -\frac{v_d}{\hat{e}} = \frac{v_d}{A_d v_d + [\dots]_{eventual mente}}$ 

**Limitazioni:**  $\frac{V_{out,min}}{A_d} < v_d(t) < \frac{V_{out,max}}{A_d}$  &  $Slew - Rate^- < \frac{dv_{out}}{dt} < Slew - Rate^+$ 

Offset di Tensione:  $V_{OFF}$  collegata al morsetto +

Correnti di Polarizzazione: Corrente  $I^+/I^- = I_{BIAS} + \frac{I_{OFF}}{2}$  ai due morsetti, uscente

$$I_{BIAS} = \frac{I^+ + I^-}{2}, \ I_{OFF} = I^+ + I^-$$

## Comparatori 7

Ottenuti con retroazione positiva.

Ottenuti con retroazione positiva.

Soglie (Invertente):  $V_{S1} = V_S \frac{R_2}{R_2 + R_1} + V_{OH} \frac{R_1}{R_1 + R_2}$   $V_{S2} = V_{S1}$  ma con OL,  $V_S$  sul '+'

Soglie (Non Invertente):  $V_{S1} = V_S(1 + \frac{R1}{R2}) - V_{OL}\frac{R1}{R2}$ ,  $V_{S2} = V_{S1}$  ma con OH,  $V_S$  sul '-' Comparatori Reali:  $V_{S1/2,reale} = V_{S1/2,ideale} - V_{OFF}$ 

## Oscillatori 8

da fare